PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-316870

(43)Date of publication of application: 29.11.1996

(51)Int.CI.

H04B 1/38 H01P 7/00

H01P 7/04

H01P 7/08

H03H 9/64

(21)Application number: 08-084175

(71)Applicant: LK PROD OY

(22)Date of filing:

05.04.1996

(72)Inventor: HAGSTROEM PANU

(30)Priority

Priority number: 95 951669

Priority date: 07.04.1995

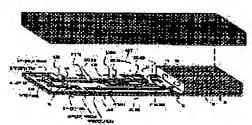
Priority country: FI

(54) RADIO COMMUNICATION TRANSCIEVER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the integration degree of a mobile telephone by including a transmitting system and a receiving system in a filter section and arranging these systems in a protection cover formed by an electrically conductive material.

SOLUTION: A filter consists of a derivative material block B, resonators 10, 11 are formed as holes in the block B, and these holes penetrate into the block B and coated with a conductive material. The resonators 10, 11 are coupled with each other on the side face of the resonator block B. An antenna switch is attained by two PIN diodes PINshunt, PINser. The bias voltage of each diode is supplied to a circuit via a port Vbias and a current-limiting resistor R/Vbias. Other individual elements and a transmission line connected to these elements form an impedance shaping circuit. A metallic cover surrounds the whole circuit to prevent interferences to the circuit.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Japanese Publication for Unexamined Patent Application No. 316870/1996 (Tokukaihei 8-316870)

A. Relevance of the Above-identified Document

This document has relevance to <u>claims 1 and 5</u> of the present application.

B. Translation of the Relevant Passages of the Document

[0044]

Figure 15 is a block diagram of a TDM wireless This TDM wireless device according to the present invention includes an antenna switch, a filter, a LNA (Low Noise Amplifier) and a mixer of the receiver, a PA (Power Amplifier) of the transmitter, and a combination body made of a directional coupler and a mixer. figure, the reference numeral 100 refers to the integration structure of the TDM wireless device. The following describes the function of the wireless device. Similarly to those shown in Figures 4(B) through 14, the filter 10 and the antenna switch 120 have composite structures that are controlled by control logics (not shown). Upon reception, the structure operates as a low-loss and low-impedance signal path from the antenna to the low noise amplifier (LNA) 130. This amplifier amplifies the received high-frequency signal. The amplified signal

passes through the band-pass filter 135, and then is mixed with a first injection signal, that is supplied from the synthesizer 200, in the mixer 140. The resulting intermediate-frequency (1F) signal passes through the band-pass filter (BPF) 180 and is sent to other section of the RX circuit of the receiver for further processing.

[0045]

The transmission system of the wireless device 100 has another local communicator signal (LO). This local communicator signal is generated in the front end section (not shown) of the transmitter, and is mixed with the first injection signal in the mixer 150. The output of the mixer 150 is connected to the power amplifier 160 via the band-pass filter 155, and the output of the power amplifier 155 is connected to the antenna switch 110/filter block 120 via the directional coupler 170. Upon transmission, the block carries out the foregoing operation to become a low-loss and low-impedance signal path from the TX port to the antenna.

[0046]

The structure of the present invention shown in Figure 15 is based on the idea of advantage of designing a wireless device in view of the filter. In the designing, the input impedance and the output impedance of the filter, and the antenna switch integrated to the filter are set to

ensure optimal impedance match with the other sections of the structure, particularly with the amplifier. With drastic designing, it is possible to omit the 50Ω impedance matching circuit, that is provided on the input side of the LNA 130 and on the output side of the PA 160.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-316870

(43)公開日 平成8年(1996)11月29日

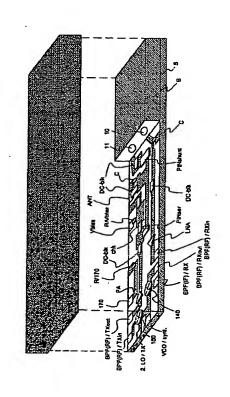
(51) Int.Cl. ⁶ H 0 4 B 1/38 H 0 1 P 7/00 7/04 7/08	職別記号 庁内 <u>整理番号</u>	FI 技術表示簡 H04B 1/38 H01P 7/00 A
H01P 7/00 7/04 7/08		H01P 7/00 A
7/04 7/08	•	
7/08		7/04
• •	7259 - 5 J	7/04
HOSH O/84		7/08
H03H 9/64		H 0 3 H 9/64 Z
		審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 14 頁
(21)出願番号	特願平8-84175	(71) 出願人 592133047
		エルケーープロダクツ オサケユイチア
(22)出顧日	平成8年(1996)4月5日	フィンランド国, エスエフー90440 ケン
		ペル, タカティー 6
(31)優先権主張番号	951669	(72) 発明者 パヌ ハグストローム
(32)優先日	1995年4月7日	フィンランド国、エフイーエン-90230
(33)優先権主張国	フィンランド (FI)	オウル, ラディオマストンテイエ 8 ^
	*	- 22
		(74)代理人 弁理士 石田 敬 (外3名)
		THE THE WAY

(54) 【発明の名称】 無線通信送受信装置

(57)【要約】

【課題】 移動電話などに用いられる無線通信送受信装置に関し、アンテナスイッチ、フィルター、方向性結合器、受信機の低雑音増幅器LNA及びミクサ140、並びに送信機の電力増幅器PA及びミクサ150を集積することにより、全ての部分が低損失基板S上に集められて干渉から保護する共通のカバー内に配列される。

【解決手段】 送信系及び受信系の支持構造は前記スイッチ及びフィルターのセクションからなる複合セクションの支持構造と同一であり、該配列に属する部品の間のガルバニック結合が前記した共通の支持構造により実現され、前記送信系及び受信系は、前記フィルターのセクションに属している。尊電性材料の保護カバーの中に位置している。なおこの実施例ではフィルターとして誘電体フィルター(誘電体材料のブロックBからなる)が用いられている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 a) 伝送線共振器から成るフィルター セクション(S_1 、 S_2 、 S_F 、 S_T)と、

- b) 低雑音増幅器(LNA)及びミクサから成る受信 系と、
- c) 電力増幅器 (PA)、方向性結合器及びミクサから成る送信系とから成る無線送受信装置において、

該フィルターセクションと関連してスイッチ手段が設けられ、該スイッチ手段は該無線送受信装置のアンテナスイッチとして作用し、前記フィルターセクション、前記受信系、及び前記送信系は構造体を形成し、その構造体において前記受信系と前記送信系とは該スイッチ手段及び該フィルターセクションと関連して配列されていて、該送信系及び該受信系の支持構造は該スイッチ手段及び該フィルターセクションから成る複合セクションの支持構造と同一であり、

該配列に属する部分の間のガルバニック結合が前記共通 支持構造により実現され、

該送信系及び該受信系は、該フィルターセクションに属 していて導電性材料で作られている保護カバーの中に位 置することを特徴とする無線通信送受信装置。

【請求項2】 該フィルターセクションは唯一のフィルター(S_1 、 S_2 、 S_F 、 S_T)から成っており、そのフィルターは或る通過帯域範囲を持っていて送信及び受信に共通である、請求項1に記載の無線通信送受信装置。

【請求項3】 該フィルターセクションの前記の或る周 波数範囲を制御信号に応じて所望の範囲に調整し得るよ うにした、請求項2に記載の無線通信送受信装置。

【請求項4】 該フィルターセクションは、伝送線共振器を含む送信部のフィルター(S_2)と受信部のフィルター(S_1)とから成っており、それは該伝送線共振器への結合を実現すると共に該伝送線共振器間の結合を実現し且つ該フィルターを該アンテナに整合させるための整合回路を有する、請求項1に記載の無線通信送受信装置。

【請求項5】 該共振器は螺旋共振器である、請求項1 に記載の無線通信送受信装置。

【請求項6】 該共振器は誘電体共振器である、請求項 1 に記載の無線通信送受信装置。

【請求項7】 該共振器はストリップライン共振器である、請求項1に記載の無線通信送受信装置。

【請求項8】 該フィルターは弾性表面波 (SAW) フィルターである、請求項1に記載の無線通信送受信装置。

【請求項9】 該受信系及び該送信系は個別の素子で実 現されている、請求項1に記載の無線通信送受信装置。 【請求項10】 該受信系及び該送信系は一つの集積回 路に実現される、請求項1に記載の無線通信送受信装

置。

【請求項11】 該受信系と該送信系と該スイッチング 手段及び該フィルターセクションから成る受動的素子と は、該共振器及び該共振器への結合のための伝送線を除 いて、MCM法(マルチチップモジュール)で実現され

ている、請求項1に記載の無線通信送受信装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

·【発明の属する技術分野】本発明は高度に集積化された 小型の無線通信送受信装置(transceiver) の構造に関する。この送受信装置の構造は、

- a) アンテナスイッチ・フィルター複合セクションを備えており、このセクションにおいて調整可能な通過帯域特性を有するフィルターが共振器で実現されており、このセクションにより、該無線装置の送信機及び受信機を、周波数分割二重(FDD(Frequency Division Duplex))方式又は時分割二重(TDD(TimeDivision Duplex))方式を使用することのできる時分割多元接続(TDMA)方式の移動電話通信網の共通アンテナに接続することができ、この送受信装置の構造は、更に、
- b) 方向性結合器と、
 - c) 該送信機に設けられた電力増幅器 (PA) 及びミクサと、
 - d) 該受信機に設けられた低雑音増幅器 (LNA) 及びミクサとを備えている。

[0002]

【従来の技術】二重機能を持っていて、時分割二重 (T DD) 方式又は周波数分割二重 (FDD) 方式を利用す る従来技術の無線装置は、送信機側及び受信機側の両方 に数個のRFフィルター(高周波フィルター)及びIF フィルター(中間周波フィルター)を備えている。図1 は従来技術の時分割多重(TDM)無線装置を示す。無 線装置101は、受信機側にバンドパスフィルター12 1を備えており、その入力ポートはアンテナスイッチ1 91に接続されている。該フィルターの出力ポートは低 雑音増幅器(LNA)171に接続されており、この増 幅器は、受信された無線信号を増幅する。その後に、第 2のバンドパスフィルター181があり、このフィルタ 一は受信された信号を更に遮波する。フィルター181 の出力ポートはミクサ111に接続され、ここで受信さ れた信号はシンセサイザ221からの第1注入信号と混 合される。その混合の結果として得られた中間周波数 (IF) 信号は、R X回路の残部に供給されて更に処理

【0003】無線装置101の送信セクションは第2局 部発振器 (LO) 信号261を備えており、この信号 は、送信機フロントエンド (図示せず) により生成され てミクサ301で該第1注入信号と混合される。ミクサ301の出力はバンドパスフィルター131に供給されるが、このフィルターは送信機の電力増幅器141の前 段におかれている。電力増幅器141の出力はローパス

フィルター又はバンドパスフィルター151の入力に接続されていて、送信される信号がアンテナを介して放射される前に望ましくない成分が送信信号から濾波されうるようになっている。電力増幅器141とバンドパスフィルター151との間には、しばしば、アンテナに入る信号の電力レベルの測定を可能にする方向性結合器(図示せず)が置かれる。

【0004】2個の連続するRFブロック(例えばLN A171とアンテナスイッチ191)と、それらの間の "オフチップ" ("off-chip") フィルター121とを 統合ないし集積回路化することは極めて困難である。該 フィルターは例えば螺旋フィルター、誘電体フィルター 又は他の類似のフィルターであり、図示の無線装置10 1で設計された機能に関してはかかるフィルターを使用 する必要がある。前記の困難の原因は、主として次のよ うな事実にある。即ち、もしその"オフチップ"フィル ターとRFプロックとが同じチップ上に集積されると、 IC技術で実現されるRFブロックと比べてフィルター のサイズが大きいために大きなサイズの接続ストリップ が必要となり、そのために、それらのストリップに起因 する電気的浮遊量と誘導性結合とによりフィルターの選 択性が損なわれることになる。実際問題としては、上記 RFブロッグ間に"オフチップ"フィルターが使用され る場合には完全な集積回路化は経済的ではないである う。従って、従来技術の時分割多重 (TDM) 無線装置 は、集中化された或いは別々の素子で実現される数個の RFブロックと、それらのブロックの間に接続されるフ ィルターとから成っている。

【0005】別々の素子とフィルターとの間のインターフェースにおける標準的インピーダンスとして50Ωが確立された。フィルター及び半導体の製造メーカーは、モジュール設計を容易にするために、入力インピーダンス及び出力インピーダンスをその標準値に合わせる。RF回路の入力インピーダンス及び出力インピーダンスはそれより低い方が好都合である場合がしばしばあり、例えばLNA171の最適入力インピーダンスレベルは約10Ωである。該標準値への適合化は整合回路で行われなければならず、この回路は別々の素子からなるか、或いは半導体メーカーはRF回路(半導体回路)の部品として集積化する。無線装置のサイズ及び価格を現在のレベルから相当低下させうるようにするためには、前記プロックを容易に集積回路化し得るような無線装置の構成を開発しなければならない。

【0006】無線送受信装置の能動的素子を全て1チップに集積することが知られている。特許公根WO93/14573は、時分割多元接続方式にもとづいて時分割二重を使用する新しい構成を示している。この公報に記載されている構成では、送受信装置の全ての能動的素子は一つの回路に集積されていて、集積化の度合いを高めることができるようになっている。しかし、この構造の

機能に不可欠のフィルターは集積回路の外側に取り残されていて、これらの回路同士の整合をとる上で顕著な問題がある。

【0007】上記の公報に開示されている設計の主な欠点は、独立の送受切換器が無ければ、時分割多元接続及び周波数分割二重(TDMA/FDD)方式を使用するシステムにそれを使うことはできず、そのために、実際上、上記公報に示されている回路の物理的サイズが殆ど2倍になるという点にある。また、その設計は、方向性結合器や自動利得制御用の直接測定接続部を含んでいない。方向性結合器は、集積回路外の伝送線路として電話の印刷基板上に直接設けられなければならないが、それでは電気的干渉を非常に受けやすくなる。印刷基板上に作られた方向性結合器は、印刷基板上に相当の面積を必要とするし、また送信機側の回路で少なくとも0.5 d Bの余分の減衰を生じさせる。この減衰は電話の電力消費に直接影響を及ぼし、従って達成し得る通話時間に直接影響を及ぼすことになる。

【0008】上記公報に開示されている設計のもう一つの欠点は、セラミック表面に形成された伝送線共振器フィルターの選択性が悪いことである。このフィルターは、送信系におけるミクサの混合結果を遮波するのに使われる。その通過帯域減衰レベルは十分に低いけれども、70MHzという低い中間周波数を使用するときには、もし混合結果に対して例えば30dBの減衰レベルが必要であるならば、選択性は全く不十分である。

【0009】更に、従来技術には送受切換器、送信機及び受信機を1チップ上に集積した送受信装置がある。この装置は米国特許第4、792、939号に開示されている。この特許の設計では、送受切換器は弾性表面波フィルター(SAW(SurfaceAcoustic Wave)フィルター)で実現されている。この設計は、受信機の低雑音増幅器(LNA)、SAW技術で実現されたバンドバスフィルター、及びミクサを集積している。該特許は、更に、電力制御に必要な回路が該設計、即ち方向性結合器及び制御ユニット、送信機の電力増幅器、及びその制御のための独立の増幅器内に集積される解決策も開示している。

【0010】この特許に開示されている解決策の問題点は、使用されるSAWフィルターと関連している。SAWフィルターは、該フィルター自体より大きな整合回路を必要とするので前記の解決策を移動電話に適用することは不可能であり、印刷基板上の伝送線として実現される該整合回路は電磁的干渉を受けやすい。SAWフィルターの電力容量は余り大きくないので、電力容量が2Wとなることのある移動電話の送信系に使用されるために、これらのSAWフィルターを組み立てて送受切換器を構成することはできない。また、SAWフィルターは温度変化の影響を非常に受けやすく、それは周波数のドリフトとなって現れる。このことを考慮せざるを得ない

のでSAWフィルターの通過情域は必要以上に広くとられる。そのために、特に、送信帯域と受信帯域との間の境界帯域が現在よりも狭くされることになっている将来の移動電話通信網においてそのような解決策を利用することは不可能となる。ちなみに、例えば、欧州通信規格協会の規格 0 5. 0 5 「欧州デジタルセルラー通信システム(段階 2);無線送受信」(ETSI (European Telecommunications Standards Institute) specification 0 5.05 "European digital cellular telecommunication system (phase 2); Radio transmission and receptio 10 n")に準拠した G S M強化システムである 将来の E ー G S M 通信網においては、境界帯域は僅かに 1 0 M H z である。また、S A W フィルターの通過帯域減衰は約3.0~4.0 d B と高いことにも留意しなければならず、これは移動電話の送信系に関しては高すぎる。

【0011】時分割多重/多元接続(TDM/TDMA(Time Division Multiplex/Multiple Access))方式はデジタルデータ通信網において広く使用されいて、送信及び受信を別々のタイムスロットで行うようになっている。もし送信周波数及び受信周波数が同一であれば、移動電話はアンテナスイッチを使ってそれらの信号を分離し、それによって、そのスイッチはアンテナを装置の送信系及び受信系に交互に接続するものである。送信及び受信が別々の周波数帯域で行われる場合には、アナログ電話に使用されている複式フィルター(duplex filter)と同様のフィルターを分離ユニットとして使用することができる。この後者の方式は、周波数分割多重/多元接続(FDM/FDMA(Frequency Division Multiplex/Multiple Access))方式を使用するシステムでも問題になる。

【0012】周波数分割二重(FDD(Frequency Divi sion Duplex))方式を使用するデジタル無線電話は、受信機の入力がある選択性を持っていなければならず、また低雑音前置増幅器を保護しなければならないので、上記のRFスイッチとは別にフィルターを必要とする。送信機の出力において、送信周波数の高調波群と、その他の例えばミラー周波数等のスプリアス送信とを減衰させなければならない。該フィルターは、送信系により受信機の帯域に生成された雑音も除去する。送信帯域より下の周波数も、別のフィルターで減衰させなければならない。DECT(Digital European Cordless Telephne(デジタル欧州コードレス電話))等の、時分割二重を使用するシステムでは、アンテナに向けて信号を送る間に発生するスプリアス送信を更に別の装置で充分に減衰させなければならない。

【0013】同じ構造の中にアンテナスイッチ及びフィルターの両方を組み込んだ解決策が従来技術にある。米国特許第5、023、935号は、フィルターとして2本の並列伝送線を使用しており、そのうちの第1の伝送線の一端はアンテナに接続されている。第2の伝送線の

6

ー端は受信機に接続されていて、この端部をPINダイオードで短絡させることができる。第2の端部は、逆バイアスがかかっているPINダイオードを通して送信機に接続されている。ダイオードと伝送線とを使用したことで充分なアイソレーションが得られており、また相互電磁結合を伴う伝送線を使っていることにより或る程度の遮波作用が得られている。しかし、この設計では、大電力を使用することはできず、また、大した濾波特性を持たせることは出来ない。この設計は、880MHzが大きいということである。この設計は、880MHzが大きいということである。この設計は、880MHzが大きいということである。この設計は、880MHzが大きいということである。この設計は、880MHzが大きいということである。この設計は、880MHzが大きいということである。この設計は、880MHzが大きいということである。

【0014】 フィンランド特許FI90926号は、時 分割多元接続システムにおいて、1周波数帯域を利用す るときにも2周波数帯域を利用するときにも伝送線共振 器で実現されるフィルターの周波数を希望の方法で高精 度に変更することを可能にする方法を開示している。こ の特許によると、該共振器は、該フィルターの三つのポ ートの間に数グループに分けられて配置されており、外 部の制御信号により例えば第2ポート及び第3ポート間 の共振器の固有周波数 (characteristic frequency) 、 又は第1ポート及び第2ポート間の共振器の固有周波数 が変化させられる。別々の共振器の共振周波数は、例え ばフィンランド特許FI88442号(米国特許第5、 298、873号) に開示されている方法で変更される が、その場合、主共振器に隣接して配置されている補助 共振器の一端が必要なときに短絡され、これにより、こ の設計の特性インピーダンスが変化して共振周波数の変 化を生じさせる。本発明においても、他の公知の方法を 利用して共振器及び該共振器を構成するフィルターの周 波数をシフトさせることができる。

【0015】フィンランド特許FI90478号は、送信系の結合器又は整合回路の伝送線をどのようにして方向性結合器の一部として使用し得るかを示している。この方法では、低損失基板上の高周波フィルターのカバーの中で、干渉及び損失を被りやすい回路基板から方向性結合器を移動させることができる。フィルターの一部となる方向性結合器を動かすとき、挿入損失が少ないために、在来の回路基板実施例と比べて約0.3dBの電力を節約することができることが測定により証明されている。

[0016]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、時分割多元接続/周波数分割多元接続、周波数分割二重/時分割二重(TDMA/FDMA、FDD/TDD (Time Division Multiple Access/Frequency Division Multiple Access, Frequency Division Duplex/Time Division Duplex) 方式を使用するデジタル移動電話システムに

適用することができ、一方ではRFスイッチ又は複式フ ィルターにもとづくアンテナスイッチの上述した欠点を 除去又は減少させ、他方では上記の各設計の利点を併せ 持つ無線送受信装置の設計を可能にすることである。本 発明の他の目的は、受信機の低雑音前置増幅器及びミク サ、並びに送信機の電力増幅器、方向性結合器及びミク サをアンテナスイッチ及びフィルターの構造と組み合わ せることによって移動電話の集積度を高めることであ

[0017]

【課題を解決するための手段】本発明の目的は、アンテ ナスイッチ、フィルター、方向性結合器、受信機のLN A及びミクサ並びに送信機のPA及びミクサを同じ統合・ 体の中に集積することにより達成され、全ての部分が一 「つの低損失基板上に集められて、干渉に対して保護する 共通のカバーの中に置かれる。この統合体は移動電話の 回路基板上の1構成要素を形成する。

【0018】本発明では、能動的素子(即ち受信機のL NA及びミクサ並びに送信機の電力増幅器及びミクサ) が組み合わされてフィルター構造の他の素子と共に同一 の基板上のフィルター構造の一部をなすことが不可欠で ある。

【0019】本発明の無線送受信装置の特徴は次の通り である、即ち、そのフィルターセクションの接続部にス イッチ手段が設けられ、該スイッチ手段は該無線送受信 装置のアンテナスイッチとして作用し、前記フィルター セクション、該装置の受信系、及び該装置の送信系は一 つの構造体を形成し、その構造体において前記受信系と 前記送信系とは該スイッチ手段及び該フィルターセクシ ョンと関連して配設されていて、

- 該送信系及び受信系の支持構造はアンテナスイッチ ・フィルター複合セクションの支持構造と同一であり、
- 該装置に属する部分の間のガルバニック結合 (galv anic connections) (導電性材料内を自由電子が流れる ことによる導電接続)が前記共通支持構造により実現さ れ、
- 該送信系及び該受信系は、該フィルターセクション に属していて電気伝導材料で作られている保護カバーの 中に位置する。

【0020】各能動的素子は、それ自体は従来技術とし て知られているディスクリートな素子として、或いは一 つのGaAs回路として、或いはマルチチップ・モジュ ールとして実現することができる。本発明の発明思想 は、前記のようにして実現された能動的素子を、フィル ター・アンテナスイッチ・方向性結合器からなる構造の 中に集積することにより、別々の素子のインターフェー スを50Ωの標準値に整合させる整合回路の主要部を除 去し得るようにすることである。

【0021】このことは、第1に、受信機側の低雑音前 置増幅器の入力側と送信機側の電力増幅器の出力側とに

整合回路が従来必要だったことを意味する。更に、該構 造に必要な全ての受動的素子を、MCM(マルチチップ モジュール)技術により例えば厚膜又は薄膜技術で回路 基板上に直接集積することができる。このようにして個 々別々の(ディスクリートな)モジュールを無くするこ とができ、該構造体全体の信頼性が向上し、その総重量 及びサイズが減少する。更に製造コストを節約すること ができる。電気的機能に関して、寄生素子が除去される ので、電気回路がより高速に、より少ない総電力消費量 で動作するようになることが重要である。

【0022】添付図面を参照して本発明及びその実施例 を詳しく説明する。

[0023]

【発明の実施の形態】初めに、図4の(B)~図14を

参照して従来技術を詳しく説明する。 【0024】図4の(B)及び(C)は、アンテナスイ ッチブロックAKとして集積されたRFスイッチKT、 Kr 及びフィルターSr 、Sr を示す。信号がTDMA /FDDシステムで送信されるとき(図4の(B))、 制御ロジック LF は信号をフィルター SF を経由させて 進ませ、RFスイッチKF は位置Tにある。フィルター Sr の中心周波数はシステムの送信周波数に対応する。 このとき、該RFスイッチは、送信される信号に対して は送信ポートへの低インピーダンス信号経路となってい る。該スイッチが位置Tにあるとき、フィルターS F は、アンテナAに対しては、該アンテナのそれと等し いインピーダンスを有する、即ち該アンテナに整合する ものとなっている。信号がTDMA/TDDシステムで 送信されるとき(図4の(C))、制御ロジックLTは RFスイッチを制御して位置Tをとらせ、一定周波数フ ィルターST 及びRFスイッチKT を介して信号をアン テナに接続する。信号が送られるとき、RFスイッチK T、KFは、受信ポートに対しては非常に高いインピー ダンスとなっていて、図4の(B)及び(C)の両方の 構成に応じて信号を減衰させる。送信のとき、RFスイ ッチKT、KFの減衰は、使用されるスイッチの種類と 構成とにより、10から70dBまでいろいろである。 【0025】TDMA/TDDシステムで図4の(C) の構成に応じて信号が受信されるとき、制御ロジックし T は信号をフィルターST を経由させてRFスイッチK Tに送り、このスイッチはそのとき位置Rにある。信号 が時分割システムで図4の(B)の構成に応じて受信さ れるときには、制御ロジック LF は、例えばフィンラン ド特許FI-88442号に開示されている方法で共振 器の周波数を変化させることにより、フィルターSFの 共振器の中心周波数を受信周波数と対応するように変化 させる。共振器の周波数をシステムの送信周波数から受 信周波数まで変化するように他の公知の方法で変化させ ることもできるということは当業者にとっては自明のこ とである。時分割システムでは、制御ロジック Lr はR

Fスイッチ K_F に位置Rをとらせて信号をフィルターS F 及びR F スイッチ K_F を介して受信ポートR Xに接続する。信号が受信されるとき、R F スイッチ K_T 、 K_F は、受信される信号に対しては、図4 O (B) 及び

(C)の両方の構成に応じて、受信ポートRXへの低インピーダンス、低反射の信号経路となる。信号が受信されるとき、RFスイッチKT、KFは、送信ポートTXに対しては非常に高いインピーダンスとなっていて、信号を減衰させる。RFスイッチKT、KFの減衰は、使用されるスイッチの種類と構成とにより、10から30dBまでいろいろである。個々別々の(ディスクリートな)ブロックで形成される図4の(A)の設計は、図4の(B)及び(C)の構成と比べると、上記したようなディスクリートな素子からなる実施例の欠点を持っている。

【0026】図5において、参照符T1は主共振器を示 すが、これは螺旋共振器、同軸共振器、誘電体共振器或 いはストリップライン共振器など、どのような種類のも のでもよい。この共振器は或る共振周波数 f を有する。 ストリップラインT2がその電磁場の中に置かれてい て、該ストリップラインはスイッチSWと短絡され得る 開放上端を有する。結合Mが該共振器間で作用する。ス イッチが開いているとき、該ストリップラインは、或る 共振周波数 f O を有する半波長共振器 (λ / 2・共振 器)として作用する。該ストリップラインの測定による と、この共振周波数f0は主共振器T1の共振周波数か ら離れすぎているので、補助共振器T2は主共振器T1 の中心周波数fに殆ど影響を与えない。スイッチSW は、閉じられると、ストリップラインの1端を短絡させ るので、それは四分の一波長共振器 (λ/4・共振器) となり、その共振周波数はf0/2で、fより高い。結 合Mは、このとき、主共振器T1の共振周波数をΔfだ け下方へシフトさせる。適当な共振周波数 f O と結合M とを選択することによってこのシフト量Δ [を希望通り の値とすることができる。結合Mは、共振器の寸法と相 対位置とにより決まる。

【0027】図6は、無線電話の複式フィルターと該電話の他のブロックとの間のインターフェースを示す。複式フィルター/方向性結合器ブロック1は4つのポート、即ち該フィルターに到来する送信信号用の一つのポート®と、一つのアンテナポートと、受信機ポートと、方向性結合器ポート⑦と、を持っている。アンテナ66から到来する受信された信号は、複式フィルター61の受信フィルターブロック63を通って受信機65へ伝播する。これと対応して、送信機64から来る信号は高さってルターブのRXアイソレーションフィルターブロック62を通ってアンテナ66へ伝播する。アンテナる成番するこの信号から、送信機の電力レベルに対応する或るレベルを持ったサンブルを方向性結合器610が取り出して、それを方向性結合器ポートに接続する。

10

【0028】図6は、複式フィルター61のRXアイソ レーションフィルター62が螺旋共振器技術で実現され ていて、方向性結合器610が該共振器の送信機側端部 における整合回路に集積されている実施例である。該方 向性結合器は、並列マイクロストリップラインで実現さ れるのが好ましい。第1ストリップラインAは、フィル ターの入力と螺旋HX1との間の結合ストリップとして 作用し、第2のストリップラインBは方向性結合器ポー ト⑦への結合ストリップとして作用する。結合ストリッ プBは抵抗器Rで終端している。図のフィルターでは、 方向性結合器をアンテナポート®の前に置くこともで き、その場合には、方向性結合器段⑦と、ストリップラ インCへの電磁結合を有するストリップラインBと、終 端抵抗器Rとから成る回路をインピーダンス整合ストリ ップラインCと並列に設けることによってそれを容易に 実現することができる。

【0029】図7は、PINダイオードで実現される周 知のRFスイッチデザインを示す。図7のRFスイッチ デザインは、フィルターと集積され得るものである。他 のRFスイッチを使用することもできる。信号が送信さ れるとき、該RFスイッチの両方のPINダイオードD 1及びD2に順方向のバイアス電圧Vbiasがかけら れる。このとき、直列接続されたPINダイオードD1 はアンテナAに向かって進む信号に対しては低インピー ダンス信号経路となり、並列接続されたPINダイオー ドD2は、受信ポートRから見てアンテナポートを実際 上短絡して、そのオーバーロードを阻止し、敏感な低雑 音前置増幅器(図1のLNA)を強い送信信号から守 る。送信モードでは、90°位相シフタPSにより並列 接続されたPINダイオードD2の低いインピーダンス を高い値に変更することによってアンテナと受信ポート Rとを分離させることができる。例えば伝送線共振器等 で実現される阻止(stop)帯域フィルターの結合素 子としては普通はLC低域通過構造が使用され、その構 造を位相シフタPSの形式でRFスイッチの一部として 利用することができる。そのLC低域通過構造は、送信 機が発生させる高調波を除去するための低域通過フィル ターをも形成する。例えばRFスイッチの受信部と並列 に接続されるPINダイオードの数を増やしてそれらを 図7の下方に点線で示されるように四分の一波長間隔で 相互接続することによってあらゆる場合に所要の絶縁性 (アイソレーション) を高めることができる。

【0030】受信が行われるとき、両方のPINダイオードD1及びD2に逆方向のバイアスがかかり、これらのダイオードは、受信される信号に対しては小さなキャパシタンスとなって、アンテナAから受信ポートRへの低インピーダンス、低損失の信号経路となる。信号を受信している間は、RFスイッチの送信部と直列に接続されるPINダイオードD1のゼロ又は逆バイアスにより生じる高インピーダンスにより送信ポートTはアンテナ

ボートAから分離される。図のデザインは、本発明に使用することのできるRFスイッチのデザインを決して限定するものではなく、RFスイッチは、例えば、当業者に周知されている、1つ以上のバイアス電圧で制御することのできる直列ー直列型又は並列ー並列型の種類のPINダイオードスイッチであっても良い。更にRFスイッチの実施例は、PINダイオードで実現されるスイッチだけに限定されるものではなく、例えばGaAs技術でも実現され得る。RFスイッチはSAWフィルターと同じ基板上に集積することができるので、その共通構造は、バッケージに納められて(場合によっては)密封されたときには非常に小型でコンパクトな素子となる。

【0031】図8は、フィルターに集積された図7のアンテナスイッチを示す。送受信のとき、共振器R1及びR2により形成される帯域ストップ構造は、それらの周波数が各々が必要とするスペースを満たすように変更されるとき、図1の送信フィルター15及び受信フィルター12と同じ機能を有する。PINダイオード及びストリップライン及びフィルターの個々別々のディスクリートな素子により形成されるアンテナスイッチは、図7のアンテナスイッチと同じ機能を有する。

【0032】送信が行われるとき、制御ロジック論理LT、LF(図4の(B) および(C)に示されている)は正の電圧をポート4に印加するので、PINダイオード8、9に順方向のバイアスがかかる。このとき、信号は、共振器10(R2)、11(R1)及びコンデンサ54~58及びコイル12からなる通過帯域フィルターを通って送信ポート1からアンテナへ進む。第2のPINダイオードの小さな順方向抵抗が、伝送線(図7及び8の実施例に示されている)、コンデンサ54、59及びコイル14から成る90°位相シフタPSにより高い抵抗に変換される(信号は約30dB減衰させられる)ので信号は受信ポート3には達しない。

【0033】受信が行われるとき、制御ロジックはゼロバイアスをポート4に印加する。すると、両方のダイオード8、9に逆バイアスがかかる。そのとき、PINダイオード8により該送信ポートのインピーダンスが信号に対して非常に高いインピーダンスとなっているので、信号はアンテナAから通過帯域フィルターを通って受信ポート3に進む。

【0034】フィルター自体に既に存在する伝送線及びコンデンサは、位相シフタ(移相回路)PS及び所要の伝送線の実現に利用されうるので、この構成によってアンテナスイッチに必要な余分の素子の数を最小限にすることができる。アンテナスイッチに必要な余分の素子は、バイアスポート4、電流制限抵抗器6(図9、図11、及び図12に示されている)、インダクタ7、PINダイオード8及び9、及びコンデンサ51~53である。フィルターは、コンデンサ54、59及びコイル14から成っていて、アンテナスイッチに必要とされる位

12

相シフタ(移相回路)PSを既に含んでいるので、この構成は、図3のように独立のフィルター及びアンテナスイッチで実現した場合と比べると素子の数が少なくなっている。フィルターに属する他の素子は、共振器10、11、コンデンサ54~58及びコイル12である。

【0035】種々の共振器に基づく種々のタイプのフィ ルターを該フィルターとして使用することができる。大 電力、高周波数の場合には、螺旋共振器又はセラミック 伝送線共振器に基づくフィルターを使用するのが好まし 10 い。また、例えば弾性表面波 (SAW) フィルター又は ストリップラインフィルターが問題となることがあるの で、共振器10及び11を、例えば図11のSAWフィ ルター15の代わりに、或いは図9の誘電体共振器の代 わりに、伝送線共振器として作られる。他の種類のフィ ルターをも使用し得ることは当業者にとっては明白であ る。送信機と受信機の間のアイソレーション減衰は30 d Bの大きさであると既に記述した。アナログ電話で は、必要なアイソレーション減衰量は一般的には60 d Bである。例えば簡単なRFスイッチでも達成し得る2 0dBのアイソレーションを遵守すると、TDMA/F DD及びTDMA/FDMAシステムのフィルターに使 用される共振器の数を少なくすることができ、従ってフ ィルターのサイズが小さくなる。例えば、フィルターに セラミック共振器を使用する場合にはアンテナスイッチ Aの全体の容積は1立方センチメートルよりかなり小さ くなると見積もることができる。

【0036】図9の(A) および(B) は、図8の回路 図の基本実施例としての誘電体フィルターを示してお り、このフィルターは、共振器が孔として形成されてい る誘電体材料のブロックから成っており、その孔は該ブ ロックを貫通していて、導電性の材料がコーティングさ れている。図9の(A)の回路構成は図8のそれと全く 同じというわけではないけれども、該実施例の主な特徴 を示している。該誘電体ブロックは、共振器のいわゆる 高インピーダンス端部が開いているブロック表面部分を 除いて、導電性の材料でコーティングされている。図に おいてこの表面は共振器の孔10、11を有する表面と して示されている。その孔のコーティングがブロックの コーティングと結合する共振器の底部は図には示されて いない。図9の(A)において図の共振器以外の他の全 ての素子は、伝送線(罫線が付されている部分)及び個 別のディスクリートな素子(例えば表面搭載素子)で形 成されており、それらは図において明るい部分として示 されている。接続タブ13は、ブロックのコーティング を結合させる、即ちそれはグランド平面として機能す る。コイル12はブロックの側面に形成されている。他 の結合パターン及び素子も該セラミックブロックの側面 に作ることができる。

【0037】図9の(B) および図10に示されている 実施例においては、共振器10、11への結合は共振器

ブロックBの側面で行われる。他の結合パターンは独立 の基板S上に配設されており、この基板Sは、セラミッ ク又はテフロンの基板であるか、或いは他の材料から成 る回路基板である。図9の(B)および図10の実施例 では、結合パターンを含む側面も、共振器ブロックBの 上面と同じく、実質的にコーティングされていない。共 振器10、11への結合のために使用される結合パター ンは、共振器ブロックBと基板Sとの間に配置されてお り、従ってそれらは図9の(B)においては見えない。 それらの結合パターンは図10に詳しく示されており、 この図は共振器プロックBを側面から見る図であり、そ れは図9の(B)においては基板Sに対向している。図 10における寸法は図9の(B)におけるブロックの寸 法とは一致しない。基板上のストリップライン16は、 図10に示されているブロックBの側面上のストリップ ライン16と結合し、それにより共振器11に電磁的に 結合している。共振器10からアンテナへの結合は結合 タブ2を通して行われ、それから信号はストリップライ ンに沿って基板Sに向けられ、該基板上で、図9の

(B) に示されているストリップライン2に送られる。【0038】図11は、図9の(A) および(B) の実施例に対応する実施例を示すが、図11では弾性表面液(SAW) フィルターがフィルターとして使用されている。例えば米国特許第5、254、962号に開示されているように、他の素子及び結合パターンが配置されている基板にSAWフィルター15を埋設することができる。

【0039】図12は螺旋共振器フィルターにおける図8の回路の実施例を示す。該フィルターの螺旋共振器は、例えばフィンランド特許FI80542号に開示されているいわゆる指支持構造(又は櫛構造)として実現することのできるものである。共振器10、11は、誘電体基板の延長部の周囲に円筒状コイルとして巻かれた金属ワイヤにより形成される。基板の下部に、例えば表面搭載素子及びストリップラインなどの個別素子に必要なストリップライン及び素子を誘電体基板に容易に付加することができ、それにより本発明のアンテナスイッチ及びフィルターのコンパクトな複合構造が得られる。数個の素子6~9、12、51~58は、この図において、接続タブにはんだ付けされた表面搭載素子として示されている。

【0040】図13は他の実施例を示しており、この実施例ではRFスイッチK及びフィルターS1及びS2は同じアンテナスイッチブロックAに集積されている。送信が行われるときには制御ロジックLはRFスイッチを位置TXに置く。このとき該RFスイッチは送信される信号に対してはTXポートからアンテナポートへの低インピーダンス信号経路となっており、送信フィルターS1は、アンテナからはアンテナインピーダンス即ちアン・50

14

テナに整合したインピーダンスに見える。受信フィルターS2 はアンテナからは非常に高いインピーダンスに見えており、信号を大幅に減衰させるので信号は受信機には達しない。RFスイッチは更にRXポートからは非常に高いインピーダンスに見えている。RFスイッチの減衰量は、スイッチの種類及び構成により10~50dBの間でいろいろである。

【0041】受信が行われるときには制御ロジックはR Fスイッチに位置RXをとらせる。このときRFスイッ チKは受信される信号に対しては低インピーダンスとなり、RXポートへの低反射信号経路となる。受信フィル ターS2 はアンテナからはアンテナインピーダンス即ち アンテナに整合したインピーダンスに見える。送信フィルターは受信帯域においては信号を減衰させる高いイン ピーダンスとなる。スイッチはTXポートからも非常に 高いインピーダンスに見える。

【0042】図14は、図13のプロック図の実施例が どのように実現されるかを回路図で示す。共振器 $R_1 \sim R_3$ から成る阻止(stop)帯域フィルターは、図2の送信フィルター S_2 と同じ機能を有する。共振器 $R_4 \sim R_6$ から成る通過帯域フィルター構造は、受信フィルター S_1 と同じ機能を有する。PINダイオード、複式フィルター(duplex filter)の伝送線、及び個別素子(ディスクリートな素子)から成るアンテナスイッチは、図7のアンテナスイッチと同じ機能を有する。

【0043】次に、図15~図18を参照して本発明と その実施例とを説明する。

【0044】図15はTDM無線装置のブロック図であ り、その送受信装置は、本発明により、アンテナスイッ チ、フィルター、受信機のLNA(低雑音増幅器)及び ミクサ、並びに送信機のPA (電力増幅器)、方向性結 合器及びミクサから成る複合体(combinatio n)を有する。その集積構造は符号100で指示されて おり、その機能は次の通りである。即ち、フィルター1 10とアンテナスイッチ120とは、図4の(B)ない し図14に記載されているものと類似していて制御ロジ ック(図示せず)により制御される複合構造を形成して いる。受信が行われるとき、この構造はアンテナから低 雑音増幅器(LNA)130への低インピーダンス、低 損失の信号経路となり、この増幅器は受信された高周波 信号を増幅する。増幅された信号は帯域通過フィルター 135で濾波され、その濾波された信号は、ミクサ14 0において、シンセサイザ200から供給される第1注 入信号と混合される。混合結果として得られる中間周波 数(IF)信号は、帯域通過フィルター(BPF)18 Oを通して受信機のRX回路の残部に送られて更に処理 される。

【0045】無線装置100の送信系はもう一つの局部 発信器信号(LO)を有し、この信号は、送信機の前端 部(図示せず)により生成されてミクサ150において

第1注入信号と混合される。ミクサ150の出力は帯域 通過フィルター155を通して電力増幅器160に向け られ、その出力は方向性結合器170を通してアンテナ スイッチ/フィルター・プロック110、120に接続 される。送信が行われるとき、このプロックは上記した ように動作して、TXポートからアンテナへの低インピーダンス、低損失の信号経路となる。

【0046】図15に示されている本発明の構造は、無線装置の設計をフィルターの設計の観点から注目することが有益であるという認識に基づいている。このとき、フィルターと、該フィルターに集積されたアンテナスイッチとの入力インピーダンス及び出力インピーダンスを、該インピーダンスが該構造の他のセクションのインピーダンス、特に増幅器のインピーダンスと最適に整合することとなるように選択することができる。 徹底的な設計により、LNA130の入力側とPA160の出力側とに設けられていた独立の50オーム・インピーダンス整合回路を無くすることができる。

【0047】図16は、図15の回路が本発明による集積構造として誘電体フィルターにおいてどのように実現されるのかを示す。図16はアンテナスイッチ及びフィルターの受動的素子に関しては図9の(B)の実施例と対応しており、共振器以外の全ての素子は伝送線(罫線が付された部分)と個別素子(ディスクリートな素子)

(例えば表面搭載素子) とから成っている。フィルター は誘電体材料のブロックBから成っており、このブロッ クにおいて共振器が孔として形成され、その孔は該ブロ ックを貫通していて伝導性材料でコーティングされてい る。共振器10、11への結合は、共振器ブロックBの 側面で行われる。他の結合パターンは独立の基板S上に 設けられており、該基板はセラミック又はテフロンの基 板、又はその他の材料の回路基板である。個別素子は図 において明るい部分として示されている。側面に結合パ ターンを形成することもできるし、個別素子を側面に固 定することもできる。能動的素子即ちLNA、PA及び ミクサ140及び150は、図16の実施例では個別素 子として示されている。それらを一つのGaAs回路に 集積することもでき、それは、参照符BPF(RF)/ RXin, BPF (RF) /RXout, BPF (R F) /TXin及びBPF (RF) /TXoutが付さ れている帯域通過フィルターのための端子を構成する。

【0048】図15において参照符120が付されているアンテナスイッチは、図16において二つのPINダイオードPINshunt及びPINserで実現されている。該ダイオードのバイアス電圧は、ポートVbiasと電流制限抵抗器R/Vbiasとを介して回路に供給される。スイッチは図7に示されているように機能し、PINshuntはダイオードD2(図7)として動作し、PINserはダイオードD1として動作する。他の個別素子及びそれに接続されている伝送線はイ

16

ンピーダンス整合回路を形成しており、それは位相シフタ (移相回路) PSとしても使われる。図は金属カバーも示しており、このカバーは回路全体を囲んで、回路への干渉を防止する。

【0049】図17は、図15の回路が本発明による集 積構造として螺旋共振器フィルターにおいてどのように 実現されるかを示す。アンテナスイッチ及びフィルター の受動的素子に関しては図17は図16の実施例と対応・ しているけれども、共振器は、支持構造として作用する 回路基板の指状延長部の周囲に巻かれた円筒状のコイル 導体即ち螺旋である。螺旋共振器への結合は、回路基板 の表面上の接続タブ(図示せず)を通して行われる。他 の結合パターンは回路基板上に設けられ、個別案子(デ ィスクリートな素子) は図において明るい部分又は罫線 が付された部分として示されている。図16の場合と同 様に、能動的素子LNA、PA及びミクサ140及び1 50は個別素子として略図示されているけれども、それ らを一つのGaAs回路に集積することもでき、それ は、参照符BPF (RF) / RXin、BPF (RF) 20 /RXout、BPF (RF) /TXin及びBPF (RF) / TXoutが付されている帯域通過フィルタ 一のための端子を構成する。PINダイオードPINs huntおよびPINserと、それらに接続されてい る回路とは、図16の実施例と同様に動作する。

【0050】図16及び17には、本発明の集積された送受信装置の一部として技術的に実現された図6の方向性結合器も示されている。図16及び17においては方向性結合器のストリップライン(図6においてはこれに参照符Bが付されている)は、電力増幅器PAからアンテナポートに向けられたストリップラインの隣に位置する。図16及び17において方向性結合器ポート170及び終端抵抗器R/170(図6ではこれらは参照符号8及びRで指示されている)は、受信機の縁に位置していて、方向性結合器のストリップラインの端部に接続されている。

【0051】図18は、図15の回路がどのようにして本発明による集積構造として実現されるかを示しており、ここではフィルターとしてセラミックフィルター又はSAWフィルターが使用されており、該構造は公知のMCM(マルチチップモジュール)技術で形成される。MCM技術の例としては下記のものがある:

MCM-C (共焼セラミックス (Cofired Cemanics))

MCM-L(有機ラミネート)

MCM-D (付着誘電体 (Deposited Dielectrics)) MCM-D/C (共焼セラミックスに誘電体が付着され た構造)

MCM-Si (無機厚膜)、及び 厚膜ハイブリッドMCM

【0052】アンテナスイッチ及びフィルターに接続されている全ての受動的素子、及び上記の能動的素子(L

NA、PA及びミクサ)はマルチチップモジュールに内蔵される。能動的素子は、公知の方法で接続された、パッケージに納められていないチップ240としてMCM構造に搭載される。その公知の方法としては、例えばダイ付着 (Die Attach) /ワイヤボンディング、タブ、フリップタブ、及びフリップチップ法がある。図には、ワイヤボンディング法による接続ワイヤ250がある。チップ、素子及び伝送線により形成される回路は、保護プラスチックケース220にモールドされている。集積体をアンテナに接続するポート210、発振器、及び該無線装置の他のセクションは、モジュールの側面上にある(図には2個のポートだけが示されている)。

[0053]

【発明の効果】マルチチップモジュール法で実現される実施例は、個別素子を集合させて作る実施例と比べると幾つかの長所がある。多層回路基板230をMCM構造に使用することができ、その場合、該構造に属するグランド平面270と素子との間の導体260を該モジュールの中に極めて自由に配置することができる。該導体は比較的に短く、そのために回路の電気的性能が向上すると共に面積を節約することができる。

【0054】本発明の集積された送受信装置をTDMA /FDDシステムの無線電話に使用するときは、在来の複式フィルター(duplex filter)の良好なアイソレーション特性及び遮波特性を維持しながら送受信装置の容積と送受信装置が回路基板上に必要とする面積とを減少させることができる。更に、RFスイッチ解決策と比べると、回路基板に挿入される素子の数が少なくなっている。TDMA/FDD方式及びTDMA/TDD方式の両方で動作するように電話を構成する必要があるかも知れない将来の二重モード(dual-mode)電話に本発明の集積構造を使用することができる。本発明に類似する構成を使用することは、狭いデュプレックスインターバル(duplex intervals)の通信網が使用されるときには特に重要になる。そのとき、在来の受動的複式フィルター

【図面の簡単な説明】

【図1】従来技術のTDM無線装置のブロック図である。

をほどよい大きさ内に設計することは不可能となる。

【図2】従来技術のRFアンテナスイッチと無線電話へのインターフェースとのブロック図である。

【図3】無線電話に使用された複式フィルターを示す図である。

【図4】(A)は別々のセクションをなすRFスイッチ及びフィルターの使用を示すブロック図であり、(B)はRFスイッチ/フィルター構造を使用する装置の前端部を示すブロック図であり、(C)は他のRFスイッチ/フィルター構造を使用する装置の前端部を示す図である。

【図5】共振器の周波数の変更を可能にする公知の方法 を示す簡略回路図である。

18

【図6】フィルターと関連させて方向性結合器を実現することを可能にする公知方法の簡略図である。

【図7】公知のアンテナスイッチのデザインの簡略回路 図であり、点線内はそのアンテナスイッチのアイソレー ションを増加させうる原理を示す図である。

【図8】図7の公知アンテナスイッチのデザインをどのようにしてフィルター構造の一部として集積し得るかを示す簡略回路図である。

【図9】(A)は図8の回路図の構造をフィルターを使って実現する方法を示す図であり、(B)は図8の回路図の構造を誘電体フィルターを使って実現する他の方法を示す図である。

【図10】図9の(B)の共振器ブロックの底面を示す 図である。

【図11】図8の回路図による構造をSAWフィルター を使って実現する方法を示す図である。

【図12】図8の回路図による構造を螺旋共振器フィルターを使って実現する方法を示す図である。

【図13】RFスイッチ/遮波アンテナスイッチを使用する装置の前端部のブロック図である。

【図14】図7による公知アンテナスイッチデザインを 複式フィルターの一部として集積する方法を示す簡略回 路図である。

【図15】本発明による送受信装置を使用するTDM無 線装置のブロック図である。

【図16】誘電体フィルターを使用して実現した図15 の送受信装置の実施例の回路図及び構造図である。

【図17】螺旋共振器フィルターを使用して実現した図15の送受信装置の実施例の回路図及び構造図である。

【図18】セラミックフィルター又はSAWフィルター 及びMCM技術を使用して実現した図15の送受信装置 の実施例の断面を示す図である。

【符号の説明】

120…アンテナスイッチ

130 (LNA) …低雑音増幅器

110、135、155、180…帯域通過フィルター 140、150…ミクサ

40 160 (PA) …電力増幅器

170…方向性結合器

200…シンセサイザ

210…ポート

220…保護プラスチックケース

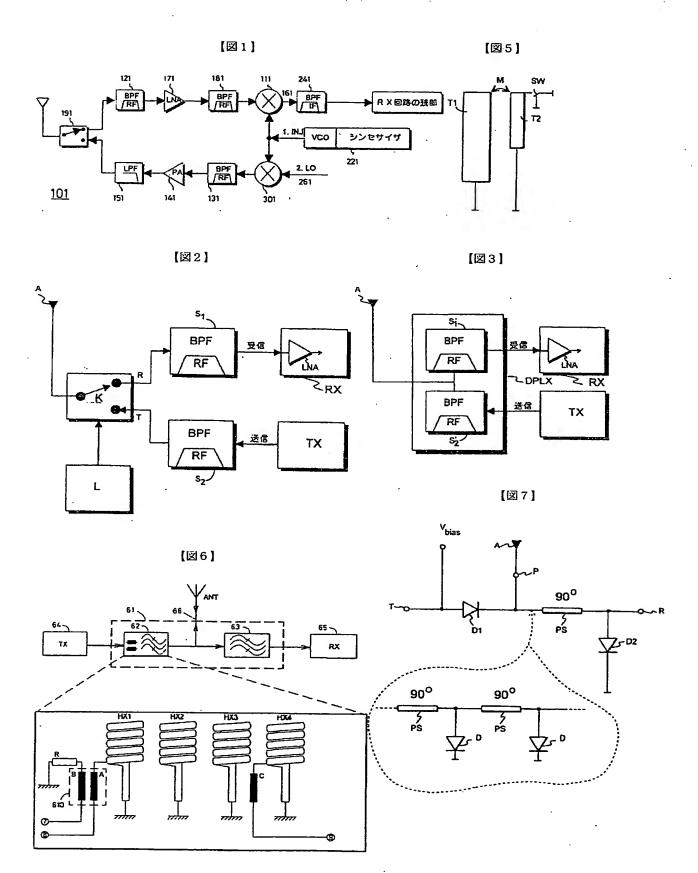
230…多層回路基板

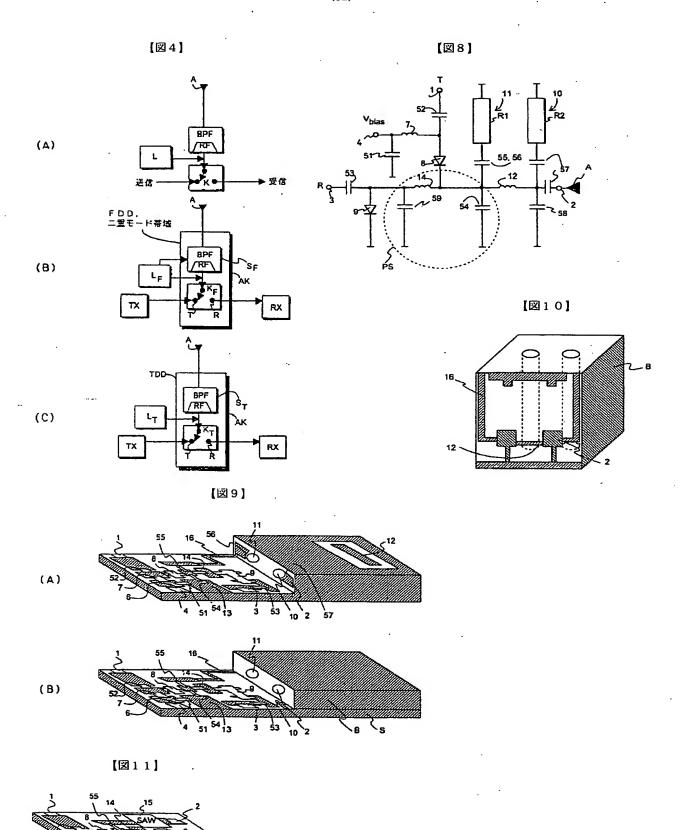
240…パッケージに納められていないチップ

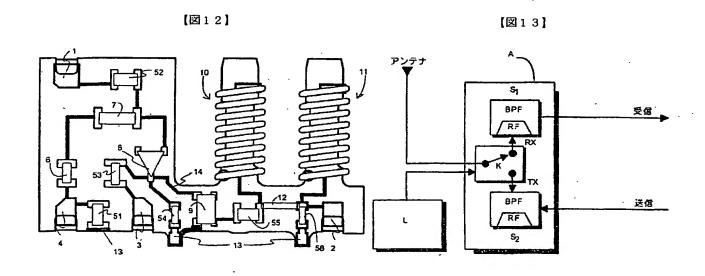
250…接続ワイヤ

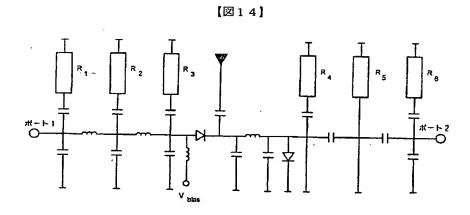
260…導体

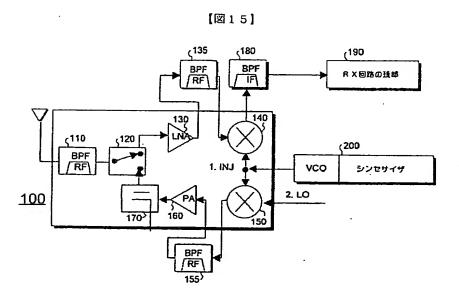
270…グランド平面



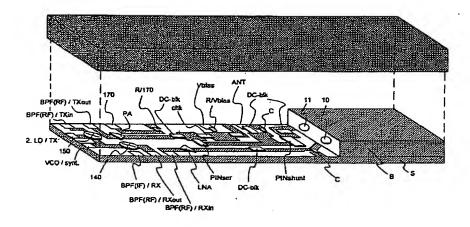




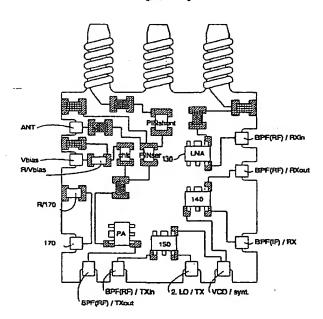




【図16】



【図17】



DC-bik

Ш с

[図18]

